

# Modelado y simulación de espaciadores nanométricos para su aplicación en dispositivos TPVs de campo cercano

Martin Augusto Reigadas Teran

Universidad Politécnica de Madrid

Septiembre, 2022

*Tutor: Pablo García-Linares Fontes*  
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica,  
Automática y Física Aplicada

*Cotutora: Esther López Estrada*  
Instituto de Energía Solar

# Tabla de Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Estado del arte
- 3 Materiales y herramientas
- 4 Métodos
- 5 Resultados y discusión
- 6 Conclusiones

# Introducción

## 1 Introducción

## 2 Estado del arte

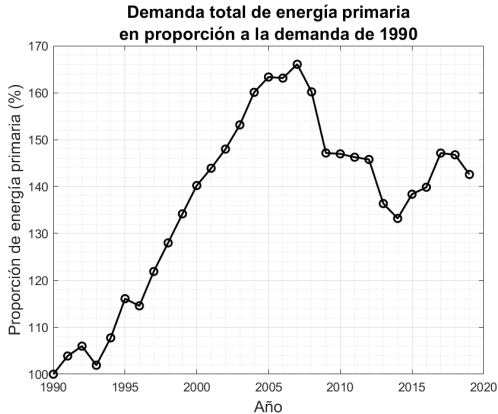
## 3 Materiales y herramientas

## 4 Métodos

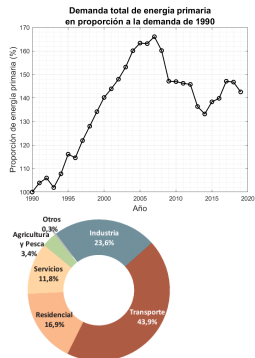
## 5 Resultados y discusión

## 6 Conclusiones

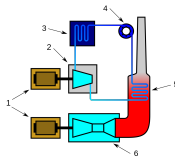
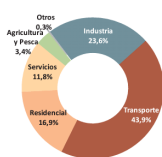
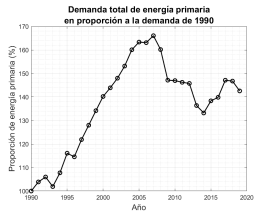
# Introducción



# Introducción



# Introducción



# Estado del arte

1 Introducción

2 Estado del arte

3 Materiales y herramientas

4 Métodos

5 Resultados y discusión

6 Conclusiones

# Estado del arte



# Materiales y herramientas

- 1 Introducción
- 2 Estado del arte
- 3 Materiales y herramientas**
- 4 Métodos
- 5 Resultados y discusión
- 6 Conclusiones

# Materiales y herramientas

# Métodos

- 1 Introducción
- 2 Estado del arte
- 3 Materiales y herramientas
- 4 Métodos**
- 5 Resultados y discusión
- 6 Conclusiones

# Métodos

# Resultados y discusión

1 Introducción

2 Estado del arte

3 Materiales y herramientas

4 Métodos

**5 Resultados y discusión**

- nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Si

- nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Ge

6 Conclusiones

# Resultados y discusión

# nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Si

- nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Si
- nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Ge

# nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Si



# nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Ge

- nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Si
- nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Ge

# nTPV Si-SiO<sub>2</sub>-Ge

# Conclusiones

- 1 Introducción
- 2 Estado del arte
- 3 Materiales y herramientas
- 4 Métodos
- 5 Resultados y discusión
- 6 Conclusiones**

# Conclusiones

# Desarrollos a futuro

